

 	EPC8002ENGR
	Hersteller-Teilenummer: EPC8002ENGR Hersteller / Marke: EPC Teil der Beschreibung: TRANS GAN 65V 2A BUMPED DIE Datenblätter:  1.EPC8002ENGR.pdf  2.EPC8002ENGR.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 2518 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC8002ENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 65V 2A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2518 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 500mA, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	21pF @ 32.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.14nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	65V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:  EPC4QI100N Altera IC CONFIG DEVICE 4MBIT 100QFP	 EPC8002ENGR EPC TRANS GAN 65V 2A BUMPED DIE	 EPC8004ENGR EPC TRANS GAN 40V 4.4A BUMPED DIE	 EPC4QC100N Altera IC CONFIG DEVICE 4MBIT 100QFP
 EPC8003ENGR EPC TRANS GAN 100V 2.5A BUMPED DIE	 EPC8003ENGR EPC TRANS GAN 100V 2.5A BUMPED DIE	 EPC8002 EPC TRANS GAN 65V 2.7A BUMPED DIE	 EPC4QC100T ALTERA EPC4QC100T ALTERA

EPC8002ENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	EPC8002ENGR Datenblatt	EPC8002ENGR-Datenblätter	EPC8002ENGR PDF	EPC EPC8002ENGR
EPC8002ENGR Electronic	EPC8002ENGR-Komponenten	EPC8002ENGR-Verteiler	EPC8002ENGR-Bild	EPC8002ENGR-Teil
EPC8002ENGR Preis	EPC8002ENGR Hersteller	EPC8002ENGR Bild	EPC8002ENGR Aktie	EPC8002ENGR Inventar
EPC8002ENGR Neu	EPC8002ENGR Original	EPC8002ENGR garantiert	EPC8002ENGR RFQ	EPC8002ENGR Online bestellen